



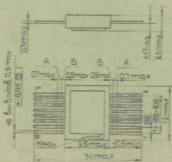
МИКРОСХЕМА К506ВЦ1

ЭТИКЕТКА

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТИПА К506ВЦ1

6К0.348.И14ТУ

1. Специальное назначение: адресный дешифратор для матриц ОЗУ на МШТ
2. Габариты: транзисторах



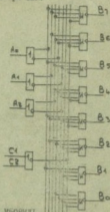
А - зона вывода, в пределах которой установлено смещение плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.

Б - длина вывода, непригодная для монтажа.

Нумерация выводов показана условно.

Форма выводов не регламентируется.

3. Функциональная схема дешифратора ОЗУ.



Цоколевка микросхемы К560ВК11

№ выв.вода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Назначение	C ₁	C ₂	A ₂	A ₁	A ₀	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	A ₀	A ₁	+5В

Таблица истинности дешифратора ОЗУ.

A ₀	A ₁	A ₂	C ₁	C ₂	B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Масса микросхемы не более 1,5 г.

В одной микросхеме содержится 42,6620 мг золота, 45,2554 мг серебра.

4. Электрические параметры микросхемы К508ВЦД при $t = 25^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{C}$:

а) токи потребления

$$I_{\text{п}1} \leq 38 \text{ мА}$$

$$I_{\text{п}2} \leq 7 \text{ мА};$$

б) входные втекающие токи:

$$I^{\text{I}}_{\text{вх}} \leq 300 \text{ мкА};$$

в) входные вытекающие токи:

$$I^{\text{O}}_{\text{вх}} \leq 1,5 \text{ мА};$$

г) выходное напряжение логического нуля (при $I^{\text{I}}_{\text{вх}} \geq 2,0 \text{ В}$,

$$I^{\text{O}}_{\text{вх}} \leq 0,7 \text{ В}; I^{\text{O}}_{\text{н}} = 1,0 \text{ мА}) I^{\text{O}}_{\text{вых}} \leq 1,3 \text{ В};$$

д) выходное напряжение логической единицы (при $I^{\text{I}}_{\text{вх}} \geq 2,0 \text{ В}$;

$$I^{\text{O}}_{\text{вх}} \leq 0,7 \text{ В}; I^{\text{O}}_{\text{н}} = 1 \text{ мА}) I^{\text{I}}_{\text{вых}} \geq 7,0 \text{ В};$$

е) время задержки включения (при $C_{\text{н}} = 220 \text{ пФ} \pm 10\%$)

$$t_{\text{в}}^{\text{IO}}$$

$$t_{\text{в}} \leq 230 \text{ нс};$$

ж) время задержки выключения (при $C_{\text{н}} = 220 \text{ пФ} \pm 10\%$)

$$t_{\text{в}}^{\text{OI}}$$

$$t_{\text{в}} \leq 200 \text{ нс};$$

з) величина ёмкости во входах $C_{\text{вх}} \leq 8 \text{ пФ}$.

5. Эксплуатационные данные:

а) напряжение питания

$$E_1 = 5 \text{ В} \pm 10\%$$

$$E_2 = 10 \text{ В} \pm 10\%$$

б) мощность, потребляемая от источника питания, не более 270 мВт;

в) диапазон рабочих температур

$$+70^{\circ}\text{C} + -25^{\circ}\text{C};$$

г) минимальная наработка 10000 часов;

д) срок хранения 6 лет.

6. Указания по эксплуатации.

Микросхемы должны применяться и эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями 0.348.114ТУ.

ДАТА ВНЕУСКА

8. * ФЕВ 1978

ВРАМН ОТ ОТК 443